

В диссертационный совет 24.1.238.02 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»

## ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Морозова Сергея Вячеславовича «Стимулированное излучение в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах в гетероструктурах с квантовыми ямами на основе HgCdTe», представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 2.2.2 — Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств**

Компактные полупроводниковые источники излучения для среднего инфракрасного диапазона востребованы как в фундаментальных исследовательских так и во многих прикладных задачах. Диссертационная работа С.В. Морозова посвящена исследованию узкозонных объемных твердых растворов кадмий-ртуть-теллур (HgCdTe) и гетероструктур с квантовыми ямами на их основе с перспективой создания источников излучения среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Данная работа объединяет изучение фундаментальных процессов рекомбинации неравновесных носителей в узкозонных полупроводниковых структурах с решением практических задач для улучшения излучательных свойств гетероструктур на основе HgCdTe, что определяет ее актуальность.

В диссертационной работе представлен ряд новых интересных результатов. В частности, на основании спектров поглощения и фотопроводимости подтверждено существование псевдорелятивистских носителей в объемных пленках узкозонных растворов HgCdTe. Экспериментально продемонстрировано, что по мере приближения закона дисперсии носителей к релятивистскому происходит подавление оже рекомбинации, и доминирующую роль занимает излучательная рекомбинация. Несомненно, одним из наиболее ярких результатов является демонстрация в волноводных гетероструктурах с множественными квантовыми ямами стимулированного излучения в диапазоне 19.5 – 31 мкм, на длинноволновой границе которого локализация волноводной моды обеспечивается за счет ограничения ее проникновения в подложку вблизи области остаточных лучей арсенида галлия.

